









	<h2 style="color: red;">GP1M003A090C</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">GP1M003A090C</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 900V 2.5A DPAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">GP1M003A090C.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 3080 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">GP1M003A090C</a>
Hersteller	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 2.5A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	3080 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	94W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.1 Ohm @ 1.25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	748pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

GP1M003A090C ist neu im Original, Suche GP1M003A090C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie GP1M003A090C Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen. Anfrage GP1M003A090C: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>GP1M004A090H</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 4A TO220</p>	 <p><b>GP1M003A090PH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 2.5A IPAK</p>	 <p><b>GP1M003A080H</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 3A TO220</p>	 <p><b>GP1M003A050PG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 2.5A IPAK</p>
 <p><b>GP1M003A080FH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 3A TO220F</p>	 <p><b>GP1M003A080CH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 3A DPAK</p>	 <p><b>GP1M005A040CG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 400V 3.4A DPAK</p>	 <p><b>GP1M003A080PH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 3A IPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

GP1A75LBJ00F	GP1FA501RZ	GP1FA501TZ	GP1FA502RZ	GP1FA513TZ
GP1FA51TK0F	GP1FA550RZ	GP1FA550TZ	GP1FA551	GP1FA551TZ
GP1FA553RZ0F	GP1FA553RZ0F	GP1FA553TZ0F	GP1FAV31TK0F	GP1FAV50RK0F
GP1FAV50TK0F	GP1FAV51TK0F	GP1FD320TP0F	GP1FM313TMF5	GP1FM313TZMF
GP1FSV51TK0F	GP1L53VJ000F	GP1L57J0000F	GP1M003A050FG	GP1M003A080CH
GP1M006A070FH	GP1M007A090H	GP1M008A025PG	GP1M009A020FG	GP1M009A090N
GP1M010A060H	GP1M010A080FH	GP1M011A050FH	GP1M013A050H	GP1M016A025CG
GP1M016A060F	GP1M016A060H	GP1S092HCPI	GP1S092HCPIF	GP1S092HCPIF
GP1S092HCPKF	GP1S093HCZ	GP1S093HCZ0F	GP1S093HCZ0F	GP1S093HCZ0F
GP1S094HCZ0F	GP1S094HCZ0F	GP1S094HCZ0F	GP1S096HCZ	GP1S096HCZ0F

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited